



本站查询

现在位置: 首页 > 研究队伍 > 导师专家库 > 硕士生导师库

导师专家库

博士生导师库

硕士生导师库

所内网站

MORE

- 中国科学院红外成像材料与器件重点实验室
- 红外物理国家重点实验室
- 973计划-InGaAs项目
- 红外联合期刊编辑部
- 教育中心
- 所网络培训平台
- 中国环境遥感网
- 所内部BBS论坛
- 图书馆网站
- 红外器件实验室

专题

MORE



唐恒敬 副研究员

| 12-07-10 | 访问次数: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】



唐恒敬, 男, 1981年生, 山东郓城人, 博士, 中国科学院上海技术物理研究所副研究员。2006年4月到2009年1月在中国科学院上海技术物理研究所攻读博士学位, 师从龚海梅研究员, 2009年2月毕业留所工作至今。近年来一直从事新型短波红外探测器的基础及应用基础研究, 在多个科研和工程项目中负责或协助负责新型InGaAs短波红外探测器的研制工作, 国家973项目学术骨干、子课题负责人, 中科院“十二五”ZC技术项目科研骨干, 并作为第一负责人承担过或正在承担国家自然科学基金青年基金、中科院创新基金和知识创新工程前沿项目。近年来第一作者在Applied Physics A和Semiconductor Science and Technology等国内外核心期刊发表9篇, 授权发明专利3项。

1. H. J. Tang, X. L. Wu, Q. F. Xu, H. Y. Liu, K. F. Zhang, Y. Wang, X. R. He, X. Li, and H. M. Gong, Effect of sulfur passivation on the InP surface prior to plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiN_x [J]. Semiconductor Science and Technology, 2008, 23: 035031.

2. H. J. TANG, X. L. WU, K. F. ZHANG, Y. F. LI, J. H. NING, Y. WANG, X. LI and H. M. GONG., The defect density of a SiN_x/In_{0.53}Ga_{0.47}As interface passivated using (NH₄)₂S_x [J]. Applied Physics A, 2008, 91: 651-655

3. 唐恒敬, 吴小利, 张可锋, 汪洋, 刘向阳, 李永富, 吴家荣, 李雪, 龚海梅, InGaAs低台面线列或面阵红外探测器芯片, 授权号: 200710047624.9 (发明专利)

唐恒敬, 张可锋, 吴小利, 朱慧, 李永富, 宁锦华, 李淘, 汪洋, 李雪, 龚海梅, 背照射铟镓砷微台面探测器芯片及制备工艺, 授权号: 200710173512.8 (发明专利)

所在单位: 中国科学院上海技术物理研究所

部 门:组件室

地 址:上海市玉田路500号

邮 编:200083

电 话:021-25051448

手 机:13

电子邮件:hjtang@mail.sitp.ac.cn

[» 评论](#)

[» 附件下载:](#)

[» 相关新闻](#)



Copyright 2003 - 2013 All Rights Reserved 上海技术物理研究所 版权所有
主办: 中国科学院上海技术物理研究所 备案序号:沪ICP备05005482号